

Pressemitteilung

X-FAB erhält Fördermittel des europäischen IPCEI ME/CT für Innovationen in der Halbleitertechnologie

Tessenderlo, Belgien – 18. Oktober 2023

Die X-FAB-Gruppe, eine führende Analog-/Mixed-Signal- und Spezial-Foundry, wird im Rahmen des neuen Projekts von gemeinsamem europäischem Interesse in der Mikroelektronik und Kommunikationstechnik (IPCEI ME/CT) umfangreiche Fördermittel erhalten. Diese Mittel in Höhe von insgesamt bis zu 80 Mio. Euro werden über einen Zeitraum von fünf Jahren von den beteiligten Regierungen Frankreichs und Deutschlands bereitgestellt. Das Programm unterstützt Innovationen in den Bereichen Mikroelektronik und Kommunikationstechnik, die eine wichtige Rolle bei der Förderung der europäischen Ziele in der Digitalisierung, Nachhaltigkeit und technologischen Souveränität spielen.

Von der Förderung profitieren drei Standorte von X-FAB, jeweils mit unterschiedlichem technologischem Fokus. Der Standort Corbeil-Essonnes in Frankreich ist auf intelligente Sensoren und Treiber, neue Architekturen, Photonik und HF-Technologien spezialisiert. Dort wurde kürzlich mit der Serienfertigung auf 200-mm-Wafern in modernster 110-nm-BCD-on-SOI-Technologie begonnen, welche im Rahmen des Vorgängerprogramms IPCEI ME entwickelt wurde.

Der Standort Erfurt in Deutschland erforscht und entwickelt eine neuartige Fertigungsplattform für smarte integrierte sensorische Systeme. X-FAB erweitert dadurch sein Technologieangebot deutlich in den Bereichen smarte Sensorsysteme, 3D-Integration und heterogene Chiplet-Integration mittels Mikro-Transferdruck, und damit auch den internationalen Stand der Technik für Technologien zur Systemintegration und für Advanced Packaging.

Am Standort Itzehoe in Deutschland wird sich X-FAB auf die Entwicklung und Umsetzung neuer Verfahren zur Bearbeitung von Glaswafern konzentrieren.

Die Förderung im Rahmen des IPCEI-ME/CT-Programms ist von strategischer Bedeutung für die Entwicklung von Halbleiterkomponenten der nächsten Generation. Die Initiative zielt darauf ab, den sich verändernden Anforderungen der Automobilindustrie sowie in der Medizin- und Industrietechnik gerecht zu werden und den Bedarf an verbesserter Datenanbindung, intelligenten Sensoren und energieeffizienten Lösungen zu decken.

Mit der Förderung wird ein breites Spektrum neuer Technologien für zahlreiche Anwendungen unterstützt, darunter intelligentes Batteriemanagement; medizinische Sensoren; Lichtsensoren (wie LiDAR und OLED); Kommunikationstechnik, die den künftigen 6G-Standards entspricht; 5G mmWave; intelligente Sensorsysteme und mikrofluidische Lösungen für biotechnologische Anwendungen.

Um dies zu erreichen, plant X-FAB die Zusammenarbeit mit mehr als 40 Industriepartnern, darunter kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), Konzerne sowie akademische Einrichtungen. Diese Kooperationen werden verschiedene Aspekte entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette abdecken.

Rudi De Winter, CEO von X-FAB, dazu: „Wir freuen uns über die IPCEI-Förderung, welche die Forschung und Entwicklung bei X-FAB unterstützt und unser Bestreben, die Grenzen der Halbleitertechnologie ständig zu erweitern. Wir haben uns der Entwicklung von Innovationen verschrieben, die wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angehen, wie die Dekarbonisierung, indem wir den Übergang zur Elektromobilität und zu erneuerbaren Energiequellen vorantreiben, sowie die Bereitstellung zuverlässiger und effizienter medizinischer Lösungen, um den Bedürfnissen unserer wachsenden und alternden Bevölkerung gerecht zu werden.“

Unser Dank geht an:

Deutschland: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Freistaat Thüringen

Frankreich: Das Projekt wird durch das französische Programm „France 2030“ unterstützt und finanziert. Weitere Informationen unter: <https://www.gouvernement.fr/france-2030>

– Ende –

Glossar

BCD-on-SOI – Bipolar-CMOS-DMOS (BCD) auf Silicon-on-Insulator (SOI)

HF – Hochfrequenz

IPCEI ME/CT – Important Project of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (wichtiges Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse in den Bereichen Mikroelektronik und Kommunikationstechnologie)

LiDAR – Light Detection and Ranging

OLED – Organic Light-Emitting Diode

TSV – Through-Silicon Via

Über X-FAB

X-FAB ist die führende Analog-Mixed-Signal- und MEMS-Foundry und fertigt Halbleiter basierend auf Siliziumwafern für die Automobil- und Konsumgüterindustrie, sowie für die Industrie- und Medizintechnik. X-FABs weltweiter Kundenstamm profitiert von höchsten Qualitätsstandards, einer exzellenten Fertigung und innovativen Technologien. X-FAB bietet modulare CMOS- und SOI-Prozesse in Geometrien von 1 µm bis 110 nm an, sowie Spezialprozesse für Siliziumkarbid- und MEMS-Technologien. X-FAB unterhält sechs Fertigungsstandorte in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den USA. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen unter xfab.com.

X-FAB Pressekontakt

Anja Noack

MarCom Manager

X-FAB Silicon Foundries

+49-361-427-6162

anja.noack@xfab.com